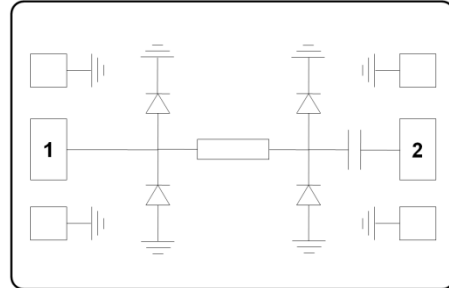




### 主要特点

- 频段: 3 - 9 GHz
- 插入损耗: 0.4 dB
- 限幅电平: 16 dBm
- 回波损耗: 20 dB
- 耐功率: 50W(CW) @3G 20W(CW)@6G
- 芯片尺寸: 1.9×1.48×0.1 mm<sup>3</sup>

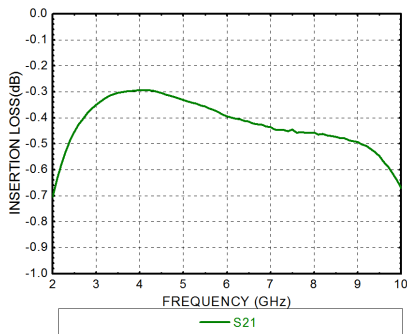
### 功能框图



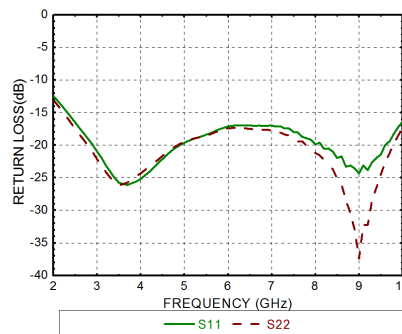
### 性能指标 (T<sub>A</sub> = +25°C)

参数	最小	典型	最大	单位
频率范围	3 - 9			GHz
插入损耗		0.4		dB
回波损耗		20		dB
限幅电平		16		dBm

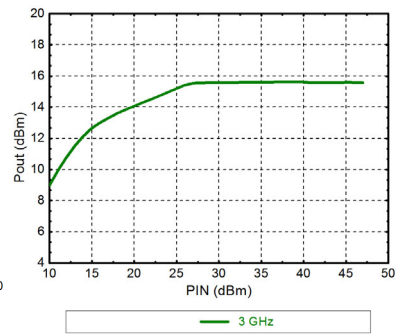
### 插入损耗



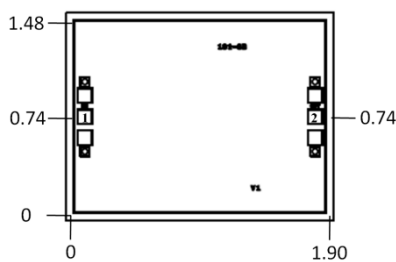
### 回波损耗



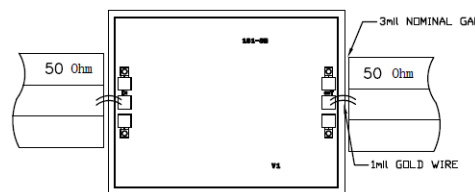
### 限幅电平



### 物理参数



### 装配图



### 注意事项

- 1、芯片背面镀金
- 2、芯片背面需接地
- 3、推荐共晶烧结工艺安装芯片
- 4、键合焊盘金属化: 金
- 5、键合焊盘尺寸为 100\*100 μm<sup>2</sup>
- 6、外形尺寸公差: ±50 μm
- 7、本产品采用空气桥工艺, 表面不带钝化层

### 焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	输入端口, 阻抗 50 Ohm, 无隔直电容
2	OUT	输出端口, 阻抗 50 Ohm, 有隔直电容
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地

### 极限参数

最大输入功率	50W@3G 20W@6G, 25° C
存储温度	-65~+150° C
工作温度	-55~+85° C